## Транспортные свойства композитов ВТСП + Ва(Pb,Met)O<sub>3</sub> в зависимости от электрических и магнитных свойств несверхпроводящих ингредиентов

© М.И. Петров, Д.А. Балаев, С.В. Оспищев, К.С. Александров

Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, 660036 Красноярск, Россия

E-mail: smp@iph.krasnoyarsk.su

(Поступила в окончательном виде 26 октября 1999 г.)

Приготовлены композиты, моделирующие сеть слабых металлических связей, состоящие из классического ВТСП со структурой 1–2–3 и металлооксида BaPbO<sub>3</sub> с внедренными в него примесями Sn, Ni и Fe. Приведены экспериментальные результаты резистивных, магнитных и мессбауэровских исследований несверхпроводящих компонентов BaPb<sub>0.9</sub>Met<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub>. Исследованы транспортные свойства композитов ВТСП + BaPb<sub>0.9</sub>Met<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub>. Наблюдается подавление сверхпроводящих свойств композитов как при уменьшении длины свободного пробега носителей в несверхпроводящих ингредиентах с примесями олова, так и вследствие дополнительного взаимодействия магнитных моментов примесей (Fe, Ni) со спином носителей сверхтока. Экспериментальные температурные зависимости критического тока композитов проанализированы в рамках теории де Жена для структур сверхпроводник–нормальный металл–сверхпроводник.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Гранта молодых ученых Сибирского отделения РАН за 1998–1999 гг.

В работе [1] нами было экспериментально показано, что компоненты ВТСП + ВаРbO<sub>3</sub> адекватны сети слабых S-N-S-связей (S — сверхпроводник, N — нормальный металл) в "чистом" пределе. Действительно, длина свободного пробега l в ВаРbO<sub>3</sub> существенно больше длины когерентности  $\xi_0$  ВТСП, и этим объясняется успешное описание транспортных свойств этих композитов теорией [2], учитывающей в "чистом" пределе и туннелирование, и эффект близости, и андреевское отражение. Однако степень слабой связи в S-N-S-структуре можно менять варьируя не только эффективную протяженность N-прослойки (что было предметом исследования в [1,3]), но и длину свободного пробега носителей в нормальном металле N.

Для низкотемпературных сверхпроводников в работе [4] детально исследовались зависимости критического тока S-N-S-перехода как в зависимости от протяженности N-прослойки, так и от длины свободного пробега носителей в ней. Длина свободного пробега и характер взаимодействия примесь–куперовская пара изменялись внедрением примесей в N-металл, причем примеси были как немагнитные, так и парамагнитные. Было получено совпадение теории, построенной на базе БКШ с экспериментом, однако не были измерены и, естественно, не анализировались температурные зависимости критического тока.

По аналогии с работой [4] мы предприняли попытку провести подобное исследование в S-N-S-структурах на основе ВТСП. К сожалению, отсутствие надежной технологии изготовления одиночных переходов заставило нас исследовать композиты ВТСП + нормальный металл. Как уже отмечалось, такие композиты адекватны сети слабых связей с некой функцией распределения по

геометрическим параметрам S-N-S-переходов — звеньев этой цепи. Однако, если технология приготовления композитов выдержана с достаточной повторяемостью, логично ожидать воспроизводимости функции распределения и все изменения транспортных свойств связать со взаимодействием носителей сверхтока при туннелировании их через металл с различными примесями.

Специфические трудности, возникающие при синтезе композитов на основе ВТСП, частично рассмотрены в [1,3]. Одна из них — окисление *N*-металла — преодолена использованием металлооксида BaPbO<sub>0</sub>, который слабо взаимодействует (в химическом смысле) с ВТСП со структурой 1-2-3 [1,3]. В нашей предварительной работе [5] было показано, что внедрение примесей в BaPbO<sub>3</sub> приводит к заметному дополнительному редуцированию сверхпроводящих свойств сети S-N-S-слабых связей в композитах ВТСП + BaPbO<sub>3</sub>.

В настоящей работе приведены подробные результаты экспериментального изучения влияния магнитных (Fe, Ni) и немагнитных (Sn) примесей, внедренных в BaPbO<sub>3</sub> на транспортные свойства композитов BTCП + Ba(Pb,Met)O<sub>3</sub>.

### 1. Синтез и физические свойства несверхпроводящих ингредиентов

Несверхпроводящие компоненты композитов готовились из окислов  $BaO_2$ , PbO, NiO,  $Fe_2^{57}O_3$ ,  $Sn^{119}O_2$  при  $880^{\circ}$ С по керамической технологии. Использование гематита, обогащенного по изотопу  $Fe^{57}$  на 90%, позволило контролировать растворимость железа в  $BaPbO_3$  с помощью мессбауэровской спектроскопии (рис. 1). Видно, что после двухнедельного отжига с промежуточными по-



**Рис. 1.** Мессбауэровские спектры  $BaPb_{0.9}Fe_{0.1}^{57}O_3$ . *а* — после первой недели синтеза, *b* — после второй недели синтеза, *с* — после третьей недели синтеза.



**Рис. 2.** Экспериментальные зависимости  $\rho(T)$  несверхпроводящих компонентов композитов в полулогарифмическом маснитабе. I — BaPbO<sub>3</sub>, 2 — BaPb<sub>0.9</sub>Sn<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub>, 3 — BaPb<sub>0.9</sub>Ni<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub>, 4 — BaPb<sub>0.9</sub>Fe<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub>.

молами исчез шестилинейчатый спектр гематита  $Fe_2^{57}O_3$ , что указывает на его "растворение" в BaPbO<sub>3</sub>. Для надежности синтез был продлен еще на неделю. Синтез BaPb<sub>0.9</sub>Ni<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub> и BaPb<sub>0.9</sub>Sn<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub> был идентичен синтезу железосодержащего BaPbO<sub>3</sub>. "Растворение" олова в BaPbO<sub>3</sub> также контролировалось с помощью эффекта Meccбауэра по изотопу Sn<sup>119</sup>. Отсутствие спектра, характерного для SnO<sub>2</sub>, свидетельствует о полном "растворении" олова в BaPbO<sub>3</sub>. Этот результат неудивителен, так как Sn<sup>4+</sup> является электронным аналогом Pb<sup>4+</sup>. Рентгеноструктурный анализ, проведенный на образцах BaPb<sub>0.9</sub>Met<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub>, показал фазу BaPbO<sub>3</sub> со структурой перовскита; никаких посторонних рефлексов в пределах точности рентгеноструктурного анализа обнаружено не было.

На рис. 2 приведены температурные зависимости удельного электросопротивления  $\rho(T)$  образцов ВаPb<sub>0.9</sub>Met<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub> и BaPbO<sub>3</sub>, измеренные четырехзондовым методом. При частичном замещении свинца кривые  $\rho(T)$  становятся слабозависящими от температуры (а для образца BaPb<sub>0.9</sub>Fe<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub> наблюдается некоторое увеличение  $\rho$  при понижении T), а абсолютные значения  $\rho$  увеличиваются, в наибольшем случае — для примесей железа (см. таблицу). Это не противоречит классическому механизму взаимодействия носителей заряда с магнитными и немагнитными примесями [6].

Некоторые параметры несверхпроводящих ингредиентов композитов

| <i>N</i> -металл                                     | $\mu,\ \mu_0$ | $\begin{array}{c}\rho\left(5\mathrm{K}\right),\\\Omega\cdot\mathrm{cm}\end{array}$ | $R_N,$<br>$\Omega \cdot \mathrm{cm}$ | <i>l</i> , Å | $T_{pb}, \mathbf{K}$ |
|--|---------------|--|--------------------------------------|--------------|----------------------|
| BaPbO <sub>3</sub>                                   |               | 0.0005   | 0.0022                               | > 100        | 0                    |
| $BaPb_{0.9}Sn_{0.1}O_3$                              | _             | 0.019  | 0.0089                               | $4.4\pm1.0$  | 0                    |
| BaPb <sub>0.9</sub> Ni <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> | 0.13          | 0.026  | 0.0098                               | $4.0\pm0.5$  | $20\pm5$             |
| BaPb <sub>0.9</sub> Fe <sub>0.1</sub> O <sub>3</sub> | 3.6           | 3.0  | 0.0524                               | $4.0\pm0.5$  | $50\pm5$             |

Примечание.  $\mu$  — магнитный момент, приходящийся на атом примеси,  $\rho$  — удельное электросопротивление,  $R_N$  — нормальное сопротивление композитов с соответствующими ингредиентами при T = 4.2 К. Значения l и  $T_{pb}$  получены из условия наилучшего описания экспериментальных  $J_C(T)$  композитов в рамках теории де Жена, см. п. 3.

На рис. З приведены результаты магнитных измерений образцов с примесями Ni и Fe. Измерения проводились на вибрационном магнетометре [7]. Сопоставлением экспериментальной кривой намагничивания M(H) с функцией Бриллюэна были определены магнитные моменты, приходящиеся на один атом примеси. Наилучшая подгонка дает значения  $3.6 \,\mu s$  для ионов Fe и  $0.13 \,\mu s$  для ионов Ni ( $\mu s$  — магнетон Бора). Для ионов железа такое значение несколько ниже номинального для Fe<sup>4+</sup> [8] в предположении, что катионы железа замещают катионы свинца в структуре BaPbO<sub>3</sub>. Что касается никеля, то можно предположить, что Ni также занимает позиции свинца в BaPbO<sub>3</sub> и его формальная валентность будет равна +4. В этом случае электронная конфигурация катиона Ni<sup>4+</sup> была бы  $3d^6$ . При такой электронной



**Рис. 3.** Магнитные изменения несверхпроводящих компонентов композитов BaPb<sub>0.9</sub>Fe<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub> (m = 96 mg) (1)' и BaPb<sub>0.9</sub>Ni<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub> (m = 112 mg) (2)'. a — полевые при T = 4.2 K, b — температурные (при H = 3 kOe) зависимости намагниченности M. Сплошные кривые — расчет по функции Бриллюэна при J = 1 для BaPb<sub>0.9</sub>Fe<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub> (1) и J = 2 для BaPb<sub>0.9</sub>Ni<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub> (2).

конфигурации низкоспиновое состояние (высокоспиновое состояние Ni<sup>4+</sup>, судя по литературе [9], никем не наблюдалось) дает нулевое значение спинового магнитного момента. Однако экспериментальное значение равно 0.13  $\mu_B$ . Возможной причиной ненулевого магнитного момента Ni может быть ковалентное подмешивание в 3*d*-уровни никеля. Таким образом, и для железа, и для никеля, находящихся в металлооксиде, наблюдается отклонение магнитного момента от номинального, что контрастирует с магнитодиэлектриками, для которых это согласие гораздо лучше [8].

Намагниченность образцов падает с ростом температуры практически по закону 1/T, что указывает на парамагнетизм соединений (рис. 3). Отсутствие гистерезиса на полевых зависимостях свидетельствует в пользу этого утверждения. Отклонение от линейного закона в области низких температур на зависимости  $M^{-1} = f(T)$  приводит к необходимости учета парных обменных взаимодействий, однако настоящая работа посвящена изучению не деталей магнетизма этих соединений, а влиянию магнитных центров рассеяния на транспортные свойства композитов с этими соединениями.

# 2. Приготовление и транспортные свойства композитов ВТСП + Ва(Pb,Met)O<sub>3</sub>

Синтез сверхпроводящего ингредиента композитов — Y<sub>0.75</sub>Lu<sub>0.25</sub>Ba<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub> — был проведен по стандартной керамической технологии. Композиты были приготовлены методом быстрого спекания [1,3]. Тщательно перемешанные ингредиенты будущих композитов в пропорции 85 vol.% ВТСП и 15 vol.% ВаРb<sub>0.9</sub>Met<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub> (Met = Sn, Ni, Fe) прессовались в виде таблеток, помещались на предварительно разогретые лодочки и вносились в печь, разогретую до температуры 950°С, на 5 min. Поскольку при такой температуре ВТСП со структурой 1-2-3 неизбежно теряет кислород, для восстановления стехиометрии по кислороду композитные образцы переносились из "высокотемпературной" печи в другую печь с температурой 400°С, где они выдерживались в течение 6 h, что достаточно для насыщения кислородом [1].

Для выяснения влияния примесей различного сорта, находящихся в несверхпроводящем компоненте, на транспортные свойства композитов полученные результаты сопоставлялись с данными, измеренными на "реперном" композите без примесей в BaPbO<sub>2</sub>.

Рентгеноструктурный анализ, проведенный на композитах, показал наличие только двух фаз — ВТСП со структурой 1–2–3 и перовскита. Постронних рефлексов в пределах точности рентгеноструктурного анализа обнаружено не было.

Обозначим композитные образцы как S + 15N, S + 15N(Sn10), S + 15N(Ni10), S + 15N(Fe10). Здесь S — сверхпроводник, N — BaPbO<sub>3</sub> без примесей, N(Sn10), N(Ni10), N(Fe10) — BaPb<sub>0.9</sub>Met<sub>0.1</sub>O<sub>3</sub> при Met = Sn, Ni, Fe соответственно.

Зависимости намагниченности от температуры M(T) композитов, измеренные в поле 200 Ос, показали нали-



Рис. 4. Экспериментальные ВАХ композитных образцов при T = 4.2 К. 1 - S + 15N, 2 - S + 15N(Sn10), 3 - S + 15N(Ni10), 4 - S + 15N(Fe10).

чие одной сверхпроводящей фазы при температуре ниже 93.5 К. Вид зависимостей M(T) подобен приведенным в работе [10] M(T) композитов ВТСП + ВаРbO<sub>2</sub>.

Рис. 4 иллюстрирует влияние различного сорта примесей в BaPbO<sub>3</sub> на вольт-амперные характеристики (BAX) композитов при T = 4.2 К. ВАХ измерялись четырехзондовым методом, для эффективного отвода тепла образец помещался непосредственно в гелиевую ванну (подробнее см. в [11,12]). ВАХ на рис. 4 характеризуются избыточным током, что характерно для S-N-S-структур [13]. В таблице приведены значения нормального сопротивления композитов  $R_N$ , определенные из линейного участка ВАХ при T = 4.2 К. Корреляция значений  $\rho$  ингредиентов и  $R_N$  очевидна.

Температурные зависимости электросопротивления R(T) композитов, измеренные четырехзондовым методом при транспортном токе  $\sim 0.01 \times J_c$  (5 K) ( $J_c$  (5 K) критический ток при 5К), приведены на рис. 5 в нормированном виде. Резкий скачок электросопротивления при 93.5 К соответствуют переходу в сверхпроводящее состояние ВТСП-гранул в композите. Неизменность этой температуры для всех композитных образцов указывает на отсутствие диффузии химических элементов из несверхпроводящих ингредиентов в ВТСП-кристталиты. Плавный "хвост" зависимостей R(T) ниже 93.5 К определяется наличием слабых связей [1,3,10,14–16]. Характерная температура, при которой сопротивление композитного образца становится равным нулю, зависит от характера примеси, внедренной в BaPbO<sub>3</sub> (рис. 5). На кривой R(T) композитов с магнитными примесями имеется протяженный по температуре участок ниже *T<sub>c</sub>* ВТСП-гранул, в котором сопротивление слабо изменяется с последующим переходом в сверхпроводящее состояние. Подобное поведение R(T) на-



Рис. 5. Экспериментальные температурные зависимости электросопротивления образцов. 1 - S + 15N, 2 - S + 15N(Sn10), 3 - S + 15N(Ni10), 4 - S + 15N(Fe10).



Рис. 6. Экспериментальные температурные зависимости плотности критического тока композитов в полулогарифмическом масштабе. 1 - S + 15N, 2 - S + 15N(Sn10), 3 - S + 15N(Ni10), 4 - S + 15N(Fe10).

блюдалось на сэндвичах YBa2Cu3O7/Pro 7Sro 3MnO3/Ag и YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub>/Pr<sub>0.7</sub>Sr<sub>0.3</sub>MnO<sub>3</sub>/YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub> с ферромагнитной прослойкой [14] и также на композитах ВТСП + диэлектрик CuO с магнитными центрами рассеяния (Ni) [15]. По-видимому, взаимодействие пар носителей с магнитными моментами в прослойках ответственно за такое поведение.

Температурные зависимости критической плотности тока  $J_c(T)$  композитов, измеренные четырехзондовым методом по стандартному критерию  $1 \,\mu V/cm$  [17] (методика подробно описана в работах [1,10]), приведены на рис. 6 Отметим некоторые особенности экспериментальных зависимостей  $J_c(T)$ . Хотя вид кривых остается примерно одинаковым для всех образцов, абсолютные значения J<sub>c</sub> (5 K) композитов сильно зависят от характера примеси (Sn, Ni, Fe), коррелируя с данными по электросопротивлению. При высоких температурах экспериментальные значения  $J_c(T)$  становятся исчезающе малыми и при конечной плотности измерительного тока ( $\sim 0.01 \times J_c(5 \, \text{K})$ ) появляется ненулевое падение напряжения (рис. 5, 6).

#### 3. Анализ температурных зависимостей критического тока композитов $BTC\Pi + Ba(Pb, Met)O_3$

Анализ зависимостей  $J_c(T)$ композитов ВТСП + ВаРbO<sub>3</sub> [1,10] показал, что композитный образец можно охарактеризовать некой средней геометрической протяженностью слабой связи *d*. Для образцов с 15 vol.% ВаРbO<sub>3</sub> эта величина, оцененная по теории [2], составила  $\sim 100$  Å. Естественно ожидать, что для композитов с примесями в BaPbO<sub>3</sub>, приготовленных по такой же технологии и с тем же содержанием несверх-проводящего ингредиента, величина *d* будет той же.

К сожалению, в настоящее время еще не существует микроскопической теории применительно к температурной зависимости критического тока для перехода от "чистого" ( $l > d_{\text{eff}}$ , где  $d_{\text{eff}}$  — эффективная протяженность слабой связи [18]) предела к "грязному" ( $l \ll d_{\text{eff}}$  [18]), подобно тому, как это было сделано для ВАХ S-N-S-контактов [19,20]. Поэтому мы приведем результаты обработки экспериментальных кривых  $J_c(T)$ в рамках теории эффекта близости де Жена [21].

При температурах, не слишком далеких от  $T_c$ , критический ток S-N-S-контакта в теории де Жена, согласно [17,22,23], определяется выражением

$$J_c(T) = C(1 - T/T_c)^2 \frac{d/\xi N}{\sinh(d/\xi N)},$$
 (1)

где C — константа, которая зависит от геометрии контакта, а в случае трехмерной сети джозефсоновских контактов с некой функцией распределения геометрических параметров играет роль нормировочного множителя; d — геометрическая протяженность N-прослойки, в случае композитов эта величина является эффективной;  $\xi_N$  — длина когерентности в N-металле или глубина проникновения пар в N-металл, определяющаяся для "грязного" N-металла как [17,22]

$$\xi_N = (\hbar V_f l / 6\pi k_B T)^{1/2}, \qquad (2)$$

где  $\hbar$  — постоянная Планка,  $k_B$  — константа Больцмана,  $V_f$  — фермиевская скорость в *N*-металле. Если *N*-прослойка является "чистым" металлом, то  $\xi_N$  не зависит от длины свободного пробега и определяется как [22]

$$\xi_N = \hbar V_f / 2\pi k_B T. \tag{3}$$

При описании экспериментальных  $J_c(T)$  подгоночными параметрами являются d и l; кроме того, необходимо знать  $V_f$ . Лучшее согласие эксперимента с теорией было достигнуто при значении  $V_r \approx 1.8 \cdot 10^7$  cm/s, полученном из соотношения  $V_f = \hbar 3^{1/3} \pi^{2/3} n^{1/3} m^{-1}$  (m — масса электрона) при  $n = 1.4 \cdot 10^{20}$  cm<sup>-3</sup> для BaPbO<sub>3</sub> по данным работы [24]<sup>1</sup>.

Кривая, удовлетворительно описавшая экспериментальную зависимость  $J_c(T)$  образца S + 15N (кривая Iна рис. 7) в области температур 55–80 K, вычислена по формулам (3) и (1) при d = 100 Å.

В случае немагнитных примесей расчетная зависимость вычислена по выражениям (2) и (1). Мы добивались наилучшего согласия эксперимента для образца



**Рис. 7.** Температурные зависимости критического тока. I - S + 15N, 2 - S + 15N(Sn10), 3 - S + 15N(Ni10), 4 - S + 15N(Fe10). Сплошные кривые — подгоночные, построены по теории де Жена, см. текст и таблицу.

S + 15N(Sn10) (кривая 2, рис. 7) и теории в области высоких температур (15–20 К ниже температуры, при которой значения  $J_c(T)$  становятся практически равными нулю), варьируя величину длины свободного пробега в выражении (2). Наилучшее согласие было достигнуто при удивительно малом значении  $4.4 \pm 1$  Å. Но простой расчет показывает, что при концентрации олова x = 0.125 наиболее вероятное расстояние между центрами рассеяния (атомами Sn) в BaPb<sub>1</sub>.  $_x$ Sn<sub>x</sub>O<sub>3</sub> будет равно постоянной решетки — 4.268 Å, а при x = 0.1 это расстояние составит 4,6 Å, что близко к полученной оценке l.

Формально можно воспользоваться теорией де Жена и для обработки  $J_c(T)$  образцов с магнитными примесями в BaPbO<sub>3</sub>, но очевидно (на рис. 7 эти зависимости находятся в области более низких температур), что получатся величины длин свободного пробега, существенно меньшие постоянной решетки, что нефизично. Это следствие того, что в страндартной теории де Жена нет механизма взаимодействия куперовских пар с магнитными моментами *N*-прослойки. Авторы работы [22] предложили, на наш взгляд, оригинальный выход, а именно среднее время жизни пары внутри *N*-прослойки  $\tau$  модифицируется и, согласно [22], будет равно

$$\tau = \tau + \tau_{pb} = (\hbar/2\pi k_B)(1/T + 1/T_{pb}).$$
(4)

(Обозначения соответствуют работе [22]). Влияние этого механизма на критический ток заключается в подстановке  $T + T_{pb}$  вместо T в формулу (3). Кривые 3и 4 на рис. 7, являющиеся наилучшей подгонкой к  $J_c(T)$ образцов S+15N(Ni10) и S+15N(Fe10) соответственно, рассчитаны по выражениям (1), (2), (4) при параметрах, указанных в таблице.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> В случае замещения Sn  $\rightarrow$  Pb из-за того что внешняя электронная конфигурация олова та же, что у свинца, для изменения *n* мало оснований. Изменение *n* при замещении никелем и железом, видимо, будет не больше, чем для BaPb<sub>1-x</sub>BiO<sub>3</sub> [24-26] и (ввиду слабости зависимости  $V_f(n) \sim n^{1/3}$ ) незначительно скажется на результатах подгонки в таблице.

При низких температурах наблюдается значительное расхождение эксперимента и теории де Жена, проиллюстрированное на рис. 7 для образца S + 15N(Fe10). Это наблюдалось и другими авторами [22,23], что неудивительно, поскольку, как уже отмечалось выше, теория эффекта близости развита для области высоких температур [21,22].

Обобщая результаты, полученные в данной работе, отметим, что магнитные примеси ухудшают транспортные свойства композитов в большей степени, чем немагнитные. Причем это подавление сильнее в случае, когда примесями являются атомы железа с гораздо большим, чем у атомов никеля, магнитным моментом. Для композитов с примесью олова в BaPbO<sub>3</sub> ухудшение сверхпроводящих свойств можно связать только с уменьшением длины свободного пробега носителей в *N*-слое. В случае композитов с магнитными примесями в BaPbO<sub>3</sub> такое редуцирование сверхпроводящих свойств связано с наличием еще одного добавочного механизма разрушения куперовских пар на магнитных моментах примесей вследствие обменного взаимодействия [4].

Этот эффект разрушения куперовских пар примесями может быть связан с неупругими процессами, такими, как магнитное рассеяние в обычных сверхпроводниках *s*-типа. Однако в сверхпроводниках *d*-типа сильное упругое рассеяние может также приводить к эффекту разрушения пар, как указано в работе [23].

Авторы благодарны А.Д. Балаеву за помощь в проведении магнитных измерений и обсуждение результатов работы, О.А. Баюкову за мессбауэровские измерения, А.Д. Васильеву за рентгеноструктурный анализ. Мы также благодарим проф. Кюммеля (Prof. Kümmel, Universität Würzburg, Germany) за интерес к работе. Одни из авторов (Д.А. Балаев) благодарен проф. Никольскому (Prof. Nicolsky, Instituto de Fisica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil) за обсуждение результатов работы.

### Список литературы

- M.I. Petrov, D.A. Balaev, S.V. Ospishchev, K.A. Sgaihutdinov, B.P. Khrustalev, K.S. Aleksandrov. Phys. Lett. A237, 85 (1997).
- [2] U. Gunsenheimer, U. Schüssler, R. Kümmel. Phys. Rev. B49, 6111 (1994).
- [3] М.И. Петров, Д.А. Балаев, С.В. Оспищев, К.А. Шийхутдинов, Б.П. Хрусталев, К.С. Александров. ФТТ **39**, *3*, 418 (1997).
- [4] J. Neimeyer, G. von Minngerode. Z. Phisic B36, 57 (1979).
- [5] M.I. Petrov, D.A. Balaev, S.V. Ospishchev, B.P. Khrustalev, K.S. Aleksandrov. Physica C282–287, 2447 (1997).
- [6] А.А. Абрикосов. Введение в теорию нормальных металлов. Наука, М. (1972). 432 с.
- [7] А.Д. Балаев, Ю.В. Бояршинов, М.М. Карпенко, Б.П. Хрусталев. ПТЭ 3, 167 (1985).
- [8] С. Крупичка. Физика ферритов и родственных им окислов.
  Т. 1. Мир, М. (1976). 353 с.

- [9] F.A. Cotton, G. Wilkinson. Advanced Inorganic Chemistry. Vol. 1–3. Jonh Wiley & Song, N.Y.–London–Sidney (1966).
- [10] М.И. Петров, Д.А. Балоев, Б.П. Хрусталев, К.С. Александров. СФХТ 8, 1, 53 (1995).
- [11] M.I. Petrov, S.N. Krivomasov, B.P. Khrustalev, K.S. Aleksandrov. Solid Stat. Commun. 82, 453 (1992).
- [12] M.I. Petrov, D.A. Balaev, D.M. Gohfeld, S.V. Ospishchev, K.A. Shaihudtinov, K.S. Aleksandrov. Physica C314, 51 (1999).
- [13] G.E. Blonder, M. Tinkham, T.M. Klapwijk. Phys. Rev. B25, 4515 (1982).
- [14] G.C. Xiong, G.J. Lian, J.F. Kang, Y.F. Hu, Y. Zhang, Z.Z. Gan. Physica C282–287, 693 (1997).
- [15] М.И. Петров, Д.А. Балаев, К.А. Шайхутдинов, С.Г. Овчинников. ФТТ 40, 8, 1599 (1998).
- [16] A. Gerber, T. Grenet, M. Cyrot, J. Beille. Phys. Rev. Lett. 65, 3201 (1990).
- [17] А. Бароне, Дж. Патерно. Физики и применение эффекта Джозефсона. Мир, М. (1984). 639 с.
- [18] K.K. Likharev. Rev. Mod. Phys. 51, 1, 101 (1979).
- [19] R. Kümmel, B. Huckestein, R. Nicolsky. Solid Stat. Commun. 65, 1567 (1988).
- [20] R. Kümmel, U. Gunsenheimer, R. Nicilsky. Phys. Rev. B42, 3932 (1990).
- [21] P.G. De Gennes. Rev. Mod. Phys. 36, 225 (1964).
- [22] L. Antogonazza, S.J. Berkowittz, T.H. Geballe, K. Char. Phys. Rev. B51, 13, 8560 (1995).
- [23] K. Char. Physica C282–287, 419 (1997).
- [24] K. Kitazawa, A. Katsui, A. Toriumi, S. Tanaka. Solid Stat. Commun. 52, 459 (1984).
- [25] T.D. Thanh, A. Koma, S. Tanaka. Appl. Phys. 22, 205 (1980).
- [26] Д.П. Моисеев, С.К. Уварова, М.Б. Феник. ФТТ 23, 8, 2347 (1981).